

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成17年2月24日(2005.2.24)

【公開番号】特開2000-264761(P2000-264761A)

【公開日】平成12年9月26日(2000.9.26)

【出願番号】特願平11-70510

【国際特許分類第7版】

C 0 4 B 41/88

C 2 3 C 18/18

【F I】

C 0 4 B 41/88 G

C 2 3 C 18/18

【手続補正書】

【提出日】平成16年3月25日(2004.3.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0039】

続いて、この膜の上に銅を真空蒸着する。本発明では、真空蒸着装置を使用して $10^{-4} \sim 10^{-6}$ Torr の真空度、蒸着速度 $0.1 \sim 100 \mu\text{m}/\text{分}$ 、好ましくは $0.5 \sim 5 \mu\text{m}/\text{分}$ で膜の上に銅を真空蒸着する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0040

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0040】

蒸着した銅は、銅もしくは酸化銅の微粒子になって膜の上に密集し、一部の微粒子が膜の中へ進入し、分散を始めており、続いて、上記膜の上に金属もしくは金属酸化物の微粒子を密集させたものを加熱する。加熱するときは、高分子あるいはオリゴマーの融点や軟化点より $10 \sim 40^\circ\text{C}$ 低い温度から融点や軟化点より $5 \sim 10^\circ\text{C}$ 高い温度で加熱すると、微粒子の均一分散を促進し、また20重量%以上の高濃度の微粒子を作成することができる。